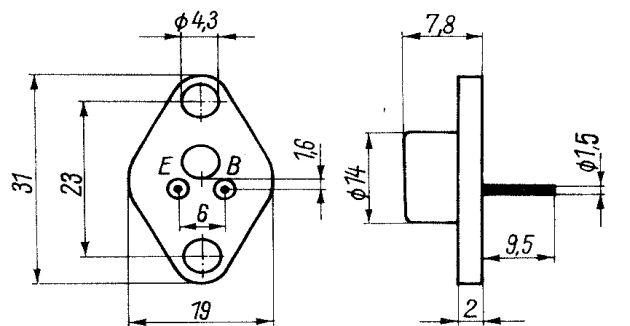


Germanium-pnp-Leistungstransistor der Bauform D nach TGL 11 811 für 60-V-Schalteranwendungen.



Masse ca. 7,5 g

Wärmewiderstand

$$R_{thjc} \leq 7,5 \text{ grad/W}$$

Grenzwerte; gültig für den Betriebstemperaturbereich

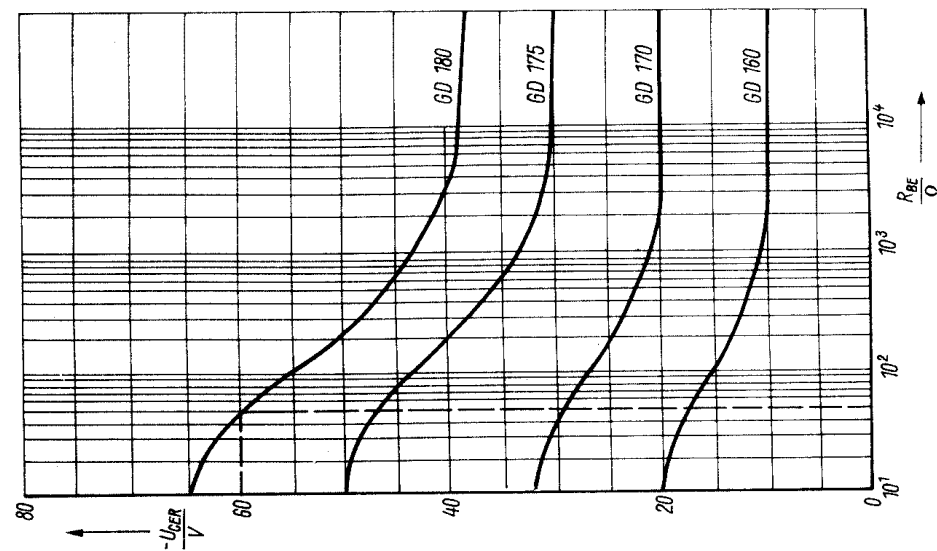
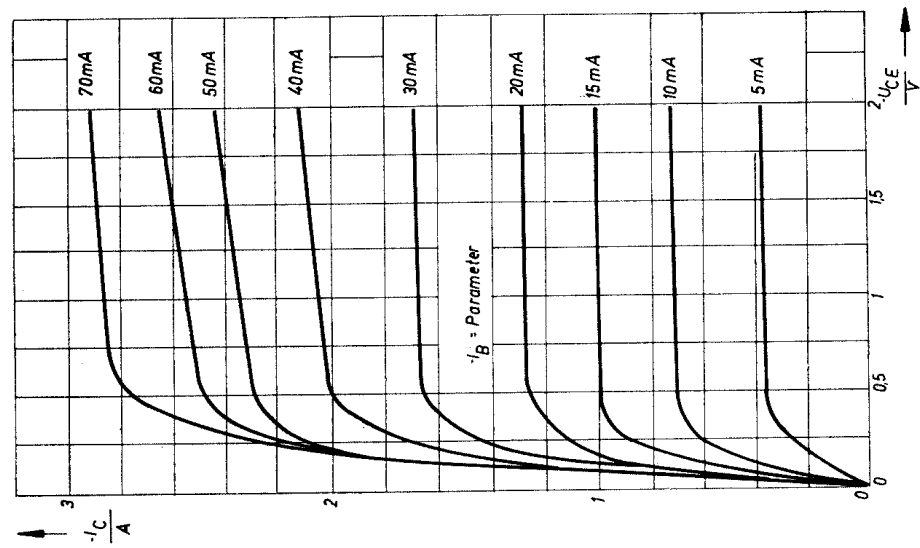
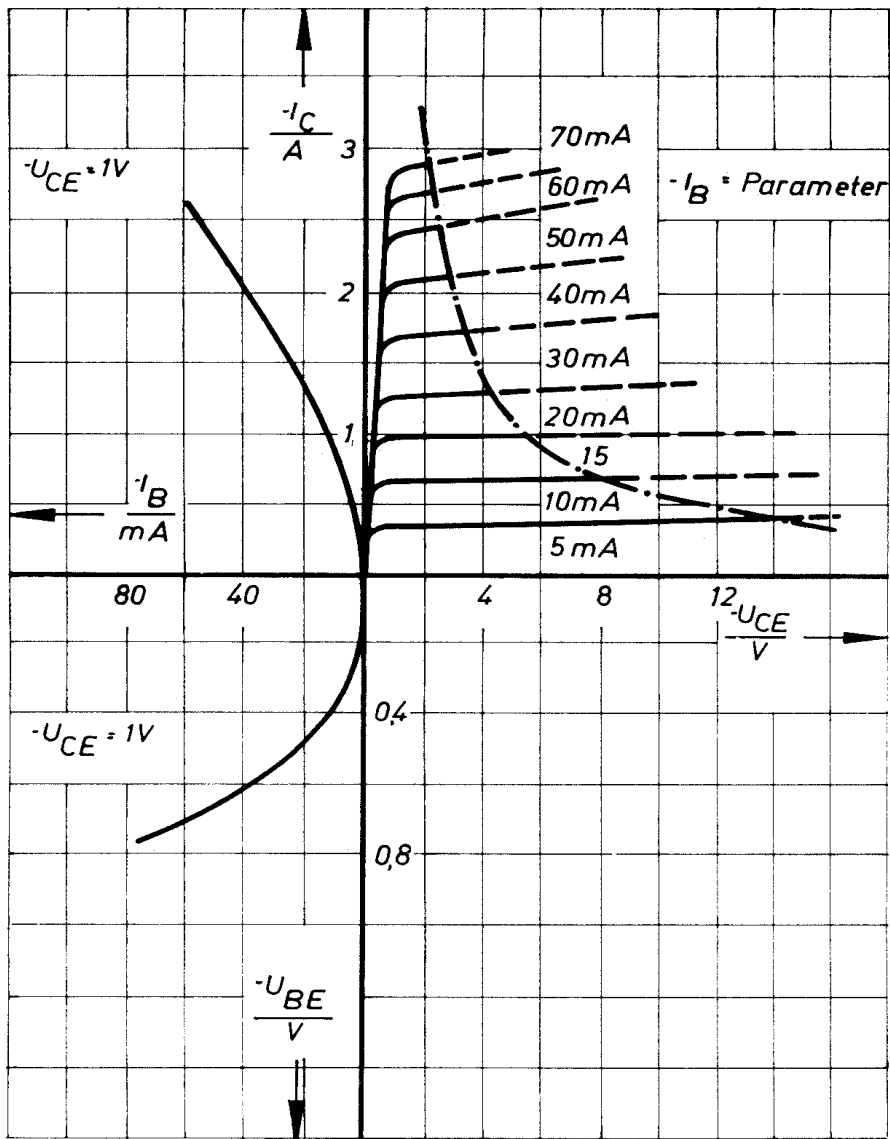
Kollektor-Basis-Spannung	$-U_{CB0} = 66 \text{ V}$
Kollektor-Emitter-Spannung	$-U_{CER} = 60 \text{ V}$
$R_{BE} = 50 \Omega$	
Kollektor-Emitter-Spannung	$-U_{CES} = 66 \text{ V}$
Emitter-Basis-Spannung	$-U_{EBO} = 10 \text{ V}$
Gesamtverlustleistung	$P_V = 5,3 \text{ W}$
Kollektorstrom	$-I_C = 3,0 \text{ A}$
Emitterstrom	$I_E = 3,6 \text{ A}$
Basisstrom	$-I_B = 0,6 \text{ A}$
Sperrschichttemperatur	$\vartheta_j = +85 \text{ }^\circ\text{C}$
Betriebstemperaturbereich	$-25 \text{ }^\circ\text{C bis } +65 \text{ }^\circ\text{C}$

Statische Kennwerte		Min.	Typ	Max.	
Kollektor-Basis-Reststrom $-U_{CB} = 6 \text{ V}$	$-I_{CBO}$		$20 \mu\text{A}$	$50 \mu\text{A}$	
Kollektor-Emitter-Reststrom $-U_{CE} = 60 \text{ V}$	$-I_{CES}$		$300 \mu\text{A}$	$1000 \mu\text{A}$	
Kollektor-Reststrom bei gesperrter Emitterdiode $-U_{EB} = 1 \text{ V}$ $-U_{CE} = 20 \text{ V}$	$-I_{CEV}$		$100 \mu\text{A}$	$1000 \mu\text{A}$	
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung $-I_B = 0,5 \text{ A}$ $-I_C = 3 \text{ A}$	$-U_{CEsat}$		$0,3 \text{ V}$	$0,6 \text{ V}$	
Basis-Emitter-Spannung $-U_{CE} = 6 \text{ V}$ $-I_C = 0,2 \text{ A}$	$-U_{BE}$		$0,35 \text{ V}$	$0,5 \text{ V}$	Stromverstärkungsgruppe
Basis-Emitter-Spannung $-U_{CE} = 2 \text{ V}$ $-I_C = 1,5 \text{ A}$	$-U_{BE}$		$0,75 \text{ V}$	$1,0 \text{ V}$	
Kollektor-Basis-Stromverhältnis $-U_{CE} = 6 \text{ V}$ $-I_C = 0,2 \text{ A}$	h_{21E}	18		35	A
		28		56	B
		45		90	C
Kurzschlußstromverstärkung $-U_{CE} = 2 \text{ V}$ $-I_C = 1,5 \text{ A}$	h_{21E}	30			
h_{21E} -Verhältnis	$\frac{h_{21E}(1,5 \text{ A})}{h_{21E}(0,2 \text{ A})}$	$0,5$			
$-U_{CB} = 2 \text{ V}$					
$-I_C = 1,5 \text{ A}$					
$-I_C = 0,2 \text{ A}$					

		Min.	Typ	Max.
Paarigkeitsbedingungen				
Verhältnis der Basisströme	$\frac{I_{B1}}{I_{B2}}$	0,833		1,2
bei				
-U _{CE}	= 6 V			
-I _c	= 0,2 A			
und				
-U _{CE}	= 2 V			
-I _c	= 3 A			
Verhältnis der Basis-Emitterspannungen	$\frac{U_{BE1}}{U_{BE2}}$	0,833		1,2
bei				
-U _{CE}	= 2 V			
-I _c	= 3 A			
Dynamischer Kennwert				
Übergangsfrequenz	f _T	180 kHz	250 kHz	
-U _{CE}	= 6 V	220 kHz	300 kHz	
-I _c	= 0,3 A	250 kHz	350 kHz	

Bestellbeispiel für einen Transistor der Stromverstärkungsgruppe C Transistor GD 180 C

Bestellbeispiel für ein Transistorpaar der Stromverstärkungsgruppe C Transistorpaar 2 GD 180 C



Kühlfläche Al 2 mm dick, blank, vertikale Lage –
bei isolierter Montage Lackpapier 0,1 mm dick.

- direkte Montage
- - - isolierte Montage
- K = Kühlfläche

